13

Пороговые процессы эмиссии ионов натрия из поверхностного сплава NaAu

© М.В. Кнатько, М.Н. Лапушкин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург E-mail: Lapushkin@ms.ioffe.rssi.ru

Поступило в Редакцию 25 ноября 2014 г.

Представлены результаты исследования пороговых процессов десорбции Na^+ из поверхностной полупроводниковой пленки Na_xAu_y , формирующейся на золотой подложке. Показано, что в отличие от классических представлений о пороговых процессах при поверхностной ионизации атомов щелочных металлов на нагретых металлических поверхностях наличие диффузионного обмена частицами между поверхностью и объемом пленки Na_xAu_y обеспечивает устойчивость эмиссии Na^+ во времени в области пороговых температур. Предложен диффузионный механизм саморегуляции поверхностного покрытия щелочного металла на пленке Na_xAu_y .

Интерметаллические соединения золота со щелочными металлами имеют ряд уникальных свойств. Пленки и кластеры Na_xAu_y , K_xAu_y , Cs_xAu_y обладают полупроводниковыми свойствами, ширина их запрещенной зоны составляет $2.6-2.8\,\mathrm{eV}$. Ранее было показано, что выращенные на поверхности золота полупроводниковые пленки являются полупроводниками n-типа. Физико-химические свойства соединений щелочных металлов с золотом зависят от стехиометрии сплава и изменяются под действием света, электронного облучения и внешнего электрического поля [1-6]. Возможность управления свойствами этих пленок позволяет рассматривать сплавы щелочных металлов с золотом в качестве перспективных материалов для нанотехнологий в химической и других отраслях промышленности.

В [1-6] было показано, что эмиссия ионов щелочного металла из полупроводниковой пленки Na_xAu_y на золоте определяется температурой эмиттера, потоком падающих атомов и процессами диффузии между пленкой сплава и ее поверхностью. Последние определяют существенные отличия кинетики изменения эмиссии ионов с поверхности пленки в нестационарных условиях в зависимости от известных законо-

мерностей в поверхностной ионизации [7,8], например, при модуляции прикладываемого к эмиттеру электрического поля. Температурные зависимости поверхностной ионизации (ПИ) атомов щелочных металлов на нагретых металлических поверхностях имеют особенность в виде пороговых процессов, результаты детальных исследований которых и их теоретическое обоснование можно найти в [8]. Было показано, что в области низких температур T за счет увеличения поверхностного покрытия атомов щелочного металла происходит уменьшение работы выхода эмиттера, что приводит к падению ионного тока и, как следствие, к дальнейшему росту поверхностного покрытия. Процесс заканчивается прекращением ионной эмиссии. Ионные токи в области пороговых температур нестабильные, температура порога зависит от интенсивности потока частиц, падающих на поверхность. ПИ атомов Na на нагретом золоте не показывает отклонений от теории [8]. Диффузионные процессы между поверхностью и объемом полупроводниковой пленки на золоте могут оказывать существенное влияние на эмиссию ионов в области пороговых температур.

В данной работе исследована эмиссия Na^+ с полупроводниковой пленки $Na_x Au_y$ в пороговой области T с целью определения влияния на нее диффузионных процессов.

В работе использовался секторный магнитный масс-спектрометр со сдвоенным источником ионов: источник с ионизацией электронным ударом и источник ионов, обеспечивающий сбор и фокусировку десорбирующихся с поверхности термоэмиттера ионов. Напыление атомов Na производили на поверхность массивного золота, выполненного в виде ленты с размерами $0.05 \times 2.5 \times 50\,\mathrm{mm}$, вырезанной из золотой фольги чистотой 99.99. Нагрев ленты осуществлялся прямым накалом. Предварительно ленту прогревали $10\,\mathrm{h}$ в вакууме при $T=1100\,\mathrm{K}$ и $30\,\mathrm{h}$ в атмосфере кислорода при давлении $2 \cdot 10^{-6}$ Torr. Эксперименты проводили при $700 < T_{\text{ленты}} < 1200 \text{ K}$ в потоке натрия $I = 10^{12} - 10^{14} \, 1/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$. Такая методика позволяет сформировать на поверхности золотой ленты ультратонкую пленку $Na_x Au_y$ толщиной несколько десятков атомных слоев и более. Формирование пленки $Na_x Au_y$ при высоких T приводит к образованию сплава со стехиометрией NaAu₂ [9]. Полученная пленка обладает высокой термической стабильностью в течение десятков часов при $T = 1250 \, \mathrm{K}$ при сохранении своих уникальных физико-химических свойств. Эксперименты проводились как при давлении $p = 10^{-8}$ Torr, так и в атмосфере кислорода при давлении $1-1.5 \cdot 10^{-6}$ Torr. К эмиттеру

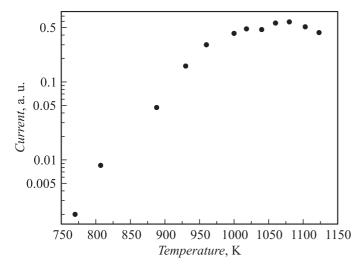


Рис. 1. Зависимость тока ионов натрия от температуры эмиттера.

можно было прикладывать вытягивающее ионы электрическое поле с напряженностью электрического поля до $E<1\cdot 10^3~{\rm V/cm}$. Модулирование потока Na нa поверхность эмиттера можно было регулировать перекрытием пучка магнитно-управляемой защелкой.

На рис. 1 представлены зависимости эмиссии Na^+ с поверхности пленки Na_xAu_y от температуры эмиттера при постоянном потоке частиц на поверхность. Как видно из рисунка, эта зависимость подобна случаю "легкой" ионизации атомов щелочных металлов [8]. Интенсивность тока ионов натрия I_0 в падающей (пороговой) части температурной зависимости, в отличие от эмиссии ионов в пороговой области температур для металлических эмиттеров, стационарна во времени в течение многих часов. Для определения механизмов, определяющих формирование ионной эмиссии и ее температурной зависимости, проведены исследования в нестационарных условиях, а именно при модуляции потока Na на поверхность. На определенные промежутки времени Δt закрывался поток атомов Na. Время переключения потока частиц на поверхность составляло порядка 1-2 s, что несоизмеримо меньше характерных времен изменения ионного тока при включении

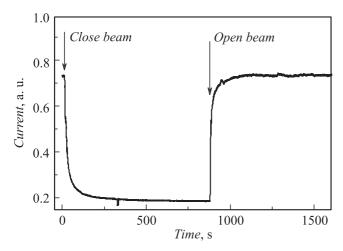


Рис. 2. Зависимость ионного тока I(t) при температуре 1120 К. Стрелками указано время открытия и закрытия потока атомов натрия.

или выключении потока частиц. После уменьшения ионного тока до нуля или стационарного значения открывался поток атомов Na на поверхность.

На рис. 2 представлена зависимость тока Na⁺ от времени после закрытия потока атомов Na на поверхность при температуре 11 200 К. Четко видно, что после закрытия потока атомов Na происходит постепенное уменьшение тока Na⁺ практически до нуля, после открытия потока атомов Na на поверхность Au происходит постепенное восстановление тока Na⁺ до первоначального значения. Незначительное уменьшение температуры эмиттера приводит к изменению формы зависимости I(t) сразу после закрытия потока атомов Na. Так для $T = 1080 \,\mathrm{K}$ (рис. 3, кривая 2) сначала происходит резкое линейное уменьшение тока I(t) на 15% от стационарного значения I_0 до минимального значения I_{\min} , после чего происходит возрастание тока до максимального значения I_{\max} , причем $I_{\max} > I_0$, с последующим уменьшением тока практически до 0. Также увеличивается время выхода тока на стационарный (нулевой) уровень. С дальнейшим уменьшением температуры эмиттера происходят уменьшения отношения I_{\min}/I_0 и возрастание отношения $I_{\rm max}/I_0$. При температуре 810 К время дости-

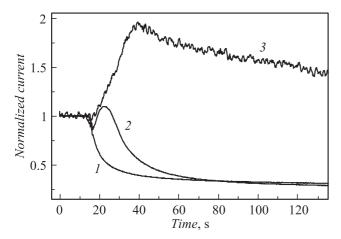


Рис. 3. Зависимости ионного тока после закрытия потока атомов натрия для трех температур: $I = 1120, 2 = 1080, 3 = 810 \,\mathrm{K}.$

жения $I_{\rm max}$ увеличивается до 20 s по сравнению с 9 s для температуры эмиттера 1080 K. Зависимость I(t) после закрытия потока атомов Na можно описать тремя экспонентами:

$$I(t) = a_0 \left(1 - e^{-\frac{x - x_0}{b_0}} \right) + a_1 e^{-\frac{x - x_0}{b_1}} + a_2 e^{-\frac{x - x_0}{b_2}} + c, \tag{1}$$

где b_0 — показатель возрастающей экспоненты, b_1 и b_2 — показатели спадающих экспонент, t_0 — время закрытия потока атомов Na, a_0 , a_1 , a_2 и c — константы. Отметим, что первое слагаемое учитывается при температурах, меньших $T < 1100\,\mathrm{K}$.

Видно из рис. 4, что показатель первой спадающей экспоненты b_1 остается постоянным при температурах от 770 до 880 К. При увеличении до $T=1020\,\mathrm{K}$ значение b_1 уменьшается на порядок. При дальнейшем увеличении T значение показателя b_1 остается постоянным и начинает снова возрастать при $T>1120\,\mathrm{K}$. Показатель второй спадающей экспоненты b_2 остается постоянным 150 ± 30 для всех температур. Показатель возрастающей экспоненты b_0 линейно убывает от $b_0=12\pm2$ при $T=770\,\mathrm{K}$ до значения $b_0=5.5\pm0.5$ при $T=1050\,\mathrm{K}$. Эксперименты показывают, что перекрывание потока атомов Na на по-

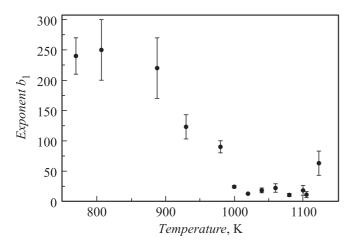


Рис. 4. Значение показателя степени первой спадающей экспоненты b_1 для различных температур.

верхность золота с формирующимся полупроводниковым слоем Na_xAu_y может приводить к изменениям распределения Na^+ как на поверхности слоя Na_xAu_y , так и в приповерхностной области слоя, что находит свое отражение в наблюдаемых временных зависимостях ионного тока.

Наблюдаемые эффекты не может объяснить классическая модель [8] формирования порогов при ПИ атомов щелочных металлов. Уменьшение температуры эмиттера в случае наличия на поверхности пленки Na_xAu_y приводит к увеличению концентрации частиц на поверхности пленки, что в свою очередь приводит к увеличению потока частиц, диффундирующих с поверхности в глубь пленки. Это не позволяет достичь на поверхности покрытий, значительно изменяющих эффективность ионизации, т. е. в области пороговых температур диффузия частиц в глубь пленки не дает развиться пороговому механизму. Наблюдается как бы предпороговое равновесие. Значительные времена достижения равновесия определяются запасанием атомов и ионов на поверхности, потоками Na^+ из слоя Na_xAu_y и в обратную сторону. При высоких температурах экспоненциальное уменьшение I(t) после закрытия потока атомов Na на поверхность может быть объяснено диффузией Na^+ из формирующегося слоя Na_xAu_y . Рост I(t) можно связать со слетом

 ${
m Na}^+$, накопленных на поверхности формирующегося слоя ${
m Na}_x{
m Au}_y$. Аналогичные эффекты наблюдаются и при больших температурах: определяющую роль играет поток ${
m Na}^+$ из приповерхностного слоя. Количество накопленного на поверхности ${
m Na}$ играет второстепенную роль.

Таким образом, показано, что перекрывание потока атомов Na на поверхность Au с формирующимся полупроводниковым слоем Na_xAu_y может приводить к изменению распределения Na между поверхностью и объемом слоя Na_xAu_y , что, в свою очередь, может изменять эффективность ионизации десорбирующихся частиц.

Список литературы

- [1] Кнатько М.В., Палеев В.И., Лапушкин М.Н. // ЖТФ. 1998. Т. 68. В. 10. С. 104–107.
- [2] Кнатько М.В., Лапушкин М.Н., Палеев В.И. // ЖТФ. 1998. Т. 68. В 10. С. 108–111.
- [3] Knat'ko M.V., Paleev V.I., Lapushkin M.N. // Phys. Low-Dim. Struct. 1998. V. 5–6.P. 85–92.
- [4] Кнатько М.В., Лапушкин М.Н., Палеев В.И. // Письма в ЖТФ. 2005. Т. 75. В. 4. С. 19–23.
- [5] Кнатько М.В., Лапушкин М.Н. // ЖТФ. 2013. Т. 83. В. 6. С. 51-59.
- [6] *Кнатько М.В., Лапушкин М.Н.* // Известия РАН. Сер. Физ. 2013. Т. 77. № 3. С. 379–381.
- [7] *Назаров Э.Г., Расулев У.Х.* Нестационарные процессы поверхностной ионизации. Ташкент: Фан, 1991. 204 с.
- [8] Зандберг Э.Я., Ионов Н.И. Поверхностная ионизация. М.: Наука, 1969. 432 с.
- [9] Xiao C., Wang Lin-Lin, Maligal-Ganesh R.V., Smetana V., Walen H., Thiel P.A., Miller G.J., Johnson D.D., Huang W. // J. Am. Chem. Soc. 2013. V. 135. N 26. P. 9592–9595.